科学研究費助成事業

研究成果報告書

1版

今和 2 年 5 月 1 9 日現在

機関番号: 87202 研究種目: 基盤研究(C)(一般) 研究期間: 2017~2019 課題番号: 17K05483 研究課題名(和文)湾曲結晶チャネリングを利用したビーム操作技術の開発

研究課題名(英文)Development of beam handling techniques using bent crystal channeling

研究代表者

高林 雄一 (TAKABAYASHI, Yuichi)

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター(産業振興部研究開発振興課、九州シンクロトロン光研究センター) ・加速器グループ・副主任研究員

研究者番号:50450953

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円

研究成果の概要(和文): 湾曲結晶チャネリングによるビーム偏向は,超伝導電磁石を凌駕する偏向能力とビ ームスプリッターへの応用が注目され,高エネルギーのイオンビームに関して研究が進んできたが,近年,GeV 級の電子ビームに関しても研究が行われるようになった.本研究では多重散乱と量子論的効果が顕著になる低エ ネルギー領域(255 MeV)において,湾曲結晶チャネリングの検証を目的とし研究を行った.(111)面が湾曲した厚 さ40ミクロンのSi単結晶を用いて実験を行ったところ,入射ビームの10%が1.4 mrad偏向された.実験結果はシ ミュレーションによって再現され,低エネルギー領域における湾曲結晶チャネリングの検証に成功した.

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究の成果は,湾曲結晶がビームスプリッターとして応用可能であることを示唆している.従来,高エネル ギーのビームを偏向させるのに電磁石が用いられてきたが,電磁石の場合,全てのビームを曲げてしまうので, ビームスプリッターとしては利用できない.よって,本研究の成果は電磁石では実現不可能な新しいビーム操作 技術に応用できる点に意義がある. また,本研究では,デチャネリング長の導出までには至らなかったが,多重散乱の影響を抑制すればデチャネリング長を導出することが可能であり,測定値が古典的な理論値と一致せず,長年,議論の的となっているデチャネリング長について新たな知見を与えられる点にも意義がある.

研究成果の概要(英文): Since bent crystal channeling was first predicted, beam deflection techniques using this method have been studied mainly for high-energy positively-charged ions, because the magnetic field strength that corresponds to the beam deflection angle exceeds that achieved by superconducting magnets, and because this technique can be applied to beam splitters. Such studies have recently been extended to electrons with GeV energies. The purpose of the present study is to investigate this phenomenon in the lower-energy region, where multiple scattering and quantum effects become dominant. A 255 MeV electron beam was supplied from the SAGA-LS linac, and a 40 micron thick Si crystal was employed as a target. The (111) planes were bent with a radius of 29 mm due to a quasi-mosaic effect. The angular distribution of electrons transmitted through the crystal was observed using a screen monitor. Ten percent of the incident electrons were deflected by 1.4 mrad, which was also reproduced by simulation.

研究分野: 加速器物理, 放射線物理

キーワード: チャネリング 湾曲結晶

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。

様 式 C-19、F-19-1、Z-19(共通)

1.研究開始当初の背景

高速の荷電粒子が結晶の軸や面に沿って,臨界角と呼ばれる角度よりも小さい角度で,ほぼ平行に入射すると,その粒子は結晶の原子列や原子面のつくる強力な電場によってガイドされな がら結晶中を進むことが知られており,その現象はチャネリングと呼ばれている.そして,結晶 を湾曲させると原子面も湾曲されるが,湾曲した原子面をチャネリングする粒子は,その原子面 に沿って結晶中を進むため,原子面の湾曲角度と同じ角度だけ偏向されることになる[1].図1に 湾曲結晶チャネリングによるビーム偏向の概念図を示す.チャネリングした粒子は湾曲した原 子面に沿って進み偏向されるが,チャネリングしなかった粒子は,volume reflection [2]と呼ばれ る効果により,チャネリング粒子とは反対方向に臨界角程度曲げられることが知られている.ま た,チャネリング粒子が,結晶内における多重散乱の影響により,チャネリング状態から外れる デチャネリングと呼ばれる現象も生じる.

この湾曲結晶チャネリングを利用したビーム偏向法は 1976年に, Tsyganov によって理論的に 予言されて以来[1],超伝導電磁石を凌駕するビーム偏向能力やビームスプリッターへの応用可 能性などが注目され, CERN, Tevatron, RHIC等の大型加速器施設において,主に高エネルギー の陽子等のイオンビームを用いて研究が行われてきた.2016年には, CERNのLHCで,6.5 TeV 陽子を用いた実験が行われたが,これはチャネリング実験における最高エネルギーとなる.一方, 2014年頃から,GeV級の電子ビームを用いた研究も精力的に行われるようになり,ドイツの MAMIで855 MeV [3],アメリカのSLACでは3.35-20.35 GeV [4,5]の電子ビームを用いて実験が 行われた.

2.研究の目的

上述したように,近年,電子ビームに関して湾曲結晶チャネリングの研究が行われるようになってきたが,今後の研究の方向性として,多重散乱の効果と量子論的効果が顕著になる,より低エネルギー領域での湾曲結晶チャネリングの検証が興味深いと考えられる.そこで,本研究では,低エネルギー領域における湾曲結晶チャネリングの検証を目的とし,SAGA-LSリニアックからの255 MeV電子ビームを用いて研究を行うこととした.

3.研究の方法

(1)湾曲結晶の開発

図 2 に,湾曲結晶の概念図を示す.結晶として,<112>軸が結晶表面に垂直なものを採用し, [111]軸のまわりに結晶を曲率半径 R で湾曲させた.この場合,quasi-mosaic 効果により,(111)面 も湾曲され,その曲率半径は R₍₁₁₁₎ = 3.54R と見積もられる[6].本研究では,この湾曲した(111) 面を用いて電子ビームの偏向を試みた.

本研究では,曲率半径固定タイプと曲率半径可変タイプの2種類の湾曲装置を開発した.曲率 半径固定タイプの湾曲装置では,目的の曲率半径で湾曲したホルダーを作製し,その湾曲面に沿 って結晶を固定することにより,結晶を湾曲させた.ただし,この方式では,結晶を取り付ける 際に結晶が割れやすい,また,曲率半径を任意の値に変えることができないという問題点がある. そこで,次に,曲率半径可変タイプの湾曲装置の開発も行った.なめらかに曲率半径を変えられ るよう試作を重ね,湾曲装置の最適化を行った.

(2) X 線回折による湾曲結晶の評価

SAGA-LS の放射光ビームライン BL15 において,ディフラクトメーターを用いて,ロッキングカーブを取得することにより,湾曲結晶の湾曲角度の評価を行った.

(3) 湾曲結晶チャネリングによるビーム偏向実験

図3に実験装置の概念図を示す.SAGA-LSリニアックからの255 MeV電子ビームを用いて, 湾曲結晶チャネリングによるビーム偏向実験を行った.結晶の上流に内径200 µmのタングステン製コリメーターを設置した.電子ビームの水平方向の角度拡がりは dx = 0.10 mrad, 垂直方向



図1:ビームの偏向角度分布の概念図.挿 入図は,湾曲結晶チャネリングの概念図.



図2:湾曲結晶の概念図.



の角度拡がりはσy=0.05 mrad であった.これらの値は,(111)面チャネリングの臨界角0.45 mrad より小さいので,チャネリングは十分観測されると考えられる.標的として,湾曲Si単結晶を 用い,真空チェンバー内に設置された2軸回転ゴニオメーターにインストールした.結晶から 5.12 m 下流に設置されているスクリーンモニタを用いて,結晶透過後のビームの角度分布を測 定した.スクリーンモニタは,厚さ100 µmのアルミナ蛍光板とCCDカメラから構成される. CCDカメラで得られたビームプロファイルの2次元データは,フレームグラバーボードを経由 してパソコンで取得し,オンラインで解析を行えるようになっている.また,CCDカメラによ るデータの取得タイミングは,ビームの入射タイミングと同期させた.

(4) シミュレーション

チャネリングに関するシミュレーションは,海外共同研究者であるロシアのトムスク工科大学の理論グループが行った.彼らはすでに,Mathematica を利用した計算コード BCM を開発していたが[7],本研究において,湾曲結晶のポテンシャルも扱えるよう計算コードの改良を行った.

4.研究成果

(1) 湾曲結晶の開発

(111)面の湾曲角度 α は,結晶の厚さを L,(111)面の曲率半径を $R_{(111)}$ とおくと,幾何学的計算 から $\alpha = L/R_{(111)}$ と求められる.つまり,ビームの偏向角度を大きくするには,結晶を厚くするか, 原子面の曲率半径を小さくする必要がある.ただし,結晶が厚いと,結晶内における多重散乱の 影響が大きくなるため,本研究では,薄い結晶を用い,原子面の曲率半径を小さくする方針で検 討を進めた.図4に,曲率半径固定タイプの湾曲結晶を示す.Si 結晶の厚さは 40 µm,曲率半径 R = 10 mmである.次に,厚さ 15 µm の Si 結晶を用いて開発した湾曲結晶を図5 に示す.曲率 半径を 5 mm(図5(b))から小さくしていき,最終的に,曲率半径を 3 mm まで小さくすること に成功した(図5(d)).曲率半径 3 mm は,この厚さにおいて,世界最小級である.

図6に,曲率半径可変タイプの湾曲結晶を示す.直径2インチ,厚さ15µmのSi結晶を取り付けた(図6(a)).少しずつ結晶を湾曲させることができるようになっており,最小の曲率半径は4mmである.曲率半径固定タイプ・可変タイプとも,研究代表者が独自に開発したものであり,今後,実験結果に応じて,すぐに改良を行えるというメリットがある.



図4:曲率半径固定タイプの湾曲結晶.厚さ40µm,曲率半径R=10mm.



図 5:曲率半径固定タイプの湾曲結晶.(a)厚さ 40 µm, R = 10 mm.(b)厚さ 15 µm, R = 5 mm,(c) 厚さ 15 µm, R = 4 mm,(d) 厚さ 15 µm, R = 3 mm.図 5(a)の結晶は,図 4 のものと同じ.



図 6:曲率半径可変タイプの湾曲結晶.(a) 直径 2 インチ,厚さ 15 µm の Si ウェハー を取り付けたところ.(b) 結晶を曲率半径 R = 4 mm まで曲げたところ.

図 7(a)に, SAGA-LS 硬 X 線ビームライン BL15 のディフラクトメーター,図 7(b)に,それを 用いて取得したロッキングカープを示す.入射 X 線のエネルギーは 10 keV,試料は図 4 で示し た湾曲 Si 結晶,回折面は(111)面である.ロッキングカーブのピーク幅から,(111)面の湾曲角度 を見積もることができるが,ピーク幅は 0.0758°(1.32 mrad)であった.

(2)湾曲結晶チャネリングによる 255 MeV 電子ビーム偏向の検証実験

図 8 に,図 4 で示した湾曲 Si 結晶を用いて測定した,ビームに対する結晶の角度 θ とビームの 偏向角度 θ_{def} 分布の関係を示す.このように,3角形状のプロファイルが得られることが知られ ている[3,4,5].1と6で示した領域が非チャネリング,2がチャネリング,3がデチャネリング, 4が volume reflection,5が volume capture を示す.volume capture とは,チャネリングしていなか った粒子が結晶内でチャネリング状態に入る現象である[2].

図8においてθ=1.4 mrad(チャネリング条件)のときの偏向角度分布を図9(a)に示す.主に, チャネリングによって偏向された成分とチャネリングしなかった成分の2 成分が観測された. 255 MeV という低エネルギー領域では予想された通り,入射電子の結晶内における多重散乱の 影響が大きく,チャネリングした成分は非チャネリング成分と大きく重なっていた.非チャネリ ング条件下の多重散乱角は0.78 mradと見積もられるが,この値は測定結果とほぼ一致していた. また,偏向角度分布は近似的に,下記の式で表されることが知られている[5].

$$I(\theta_{def}) = I_{VR}(\theta_{def}) + I_{CH}(\theta_{def}) + I_{DC}(\theta_{def}), \qquad (1)$$

$$I_{\rm VR}(\theta_{\rm def}) = \frac{P_1}{\sqrt{2\pi\sigma_1}} \exp\left(-\frac{(\theta_{\rm def}-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right),\tag{2}$$

$$I_{\rm CH}(\theta_{\rm def}) = \frac{P_2}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left(-\frac{(\theta_{\rm def}-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right),\tag{3}$$

$$H_{\rm DC}(\theta_{\rm def}) = \frac{1 - P_1}{2\theta_{\rm d}} \exp\left(\frac{\sigma_2^2}{2\theta_{\rm d}^2} + \frac{\mu_1}{\theta_{\rm d}} - \frac{\theta_{\rm def}}{\theta_{\rm d}}\right) \left(\exp\left(\frac{\mu_2 - \Delta\theta_{\rm def}}{\sqrt{2}\sigma_2}\right) - \exp\left(\frac{\mu_1 - \Delta\theta_{\rm def}}{\sqrt{2}\sigma_2}\right)\right). \tag{4}$$

ここで, $I_{VR}(\theta_{def})$ は非チャネリング成分 (volume reflection), $I_{CH}(\theta_{def})$ はチャネリング成分, $I_{DC}(\theta_{def})$ はデチャネリング成分を表す.また, $P_2 = (1 - P_1)e^{-L/L_d}$, $\Delta \theta_{def} = \theta_{def} - \sigma_2^2/\theta_d$, $\theta_d = \theta_b L_d/L$, $erf(\theta_{def})$ はエラー関数, Lは結晶の厚さ, L_d はデチャネリング長, θ_b は結晶面の湾曲角度, そして, P_1 , σ_1 , μ_1 , σ_2 , μ_2 , L_d がフィッティングパラメータである.図 9(a)の赤線は(1)式によるフィットを示し, 青線は $I_{VR}(\theta_{def})$, 緑線は $I_{CH}(\theta_{def})$ を示す.チャネリングして偏向された成分は 10%, 偏向角度は 1.38 mrad であった.この値は, X 線回折で求めた結晶の湾曲角度 1.32 mrad とほぼ一致する.なお,多重散乱の影響が大きく、チャネリング成分と非チャネリング成分が大きく重なっていたため、デチャネリング成分を導出することはできなかった.



図 7: (a) SAGA-LS 硬 X 線ビームライン BL15 のディフラクトメーター. (b) 厚さ 40 µm, *R* = 10 mm の湾曲 Si 結晶に関するロッキングカーブ.





図 8:ビームに対する結晶の角度 θ とビームの偏 向角度 θ_{def} 分布の関係.1と6:非チャネリング, 2:チャネリング,3:デチャネリング,4:volume reflection,5:volume capture.

図 9: ビームの偏向角度分布 .(a) 実 験結果,(b) シミュレーション結果. 赤線:(1)式によるフィット.青線: 非チャネリング成分.緑線:チャネ リング成分.

図 9(b)に,計算コード BCM を用いたシミュレーションの結果を示す.計算コードにはデチャ ネリング過程も取り入れられている.シミュレーションは測定結果をよく再現していた.シミュ レーション結果に対しても実験結果と同様,(1)式によるフィットを行ったところ,チャネリン グにより偏向された成分は11%,偏向角度は1.45 mrad と求められたが,これらの値は測定結果 とほぼ一致していた.

ビームの偏向角度分布において, チャネリング成分を非チャネリング成分から分離させるためには,多重散乱による角度拡がりを抑制しなければならず,そのためには,より薄い結晶を用いる必要がある.今後,図5・図6で示した厚さ15 µmのSi結晶を用いて研究を継続する予定である.

参考文献

- [1] E. N. Tsyganov, Preprint TM-682, TM-684, Fermilab, Batavia, 1976.
- [2] A. M. Taratin and S. A. Vorobiev, Phys. Lett. A 119, 425 (1987).
- [3] A. Mazzolari et al., Phys. Rev. Lett. 112, 135503 (2014).
- [4] U. Wienands et al., Phys. Rev. Lett. 114, 074801 (2015).
- [5] T. N. Wistisen et al., Phys. Rev. Accel. Beams 19, 071001 (2016).
- [6] R. Camattari, V. Guidi, V. Bellucci, and A. Mazzolari, J. Appl. Cryst. 48, 977 (2015).
- [7] S. V. Abdrashitov, O. V. Bogdanov, K. B. Korotchenko, Yu. L. Pivovarov, E. I. Rozhkova,
 - T. A. Tukhfatullin, and Yu. L. Eikhorn, Nucl. Instrum. Methods B 402, 106 (2017).
- [8] Y. Takabayashi, Yu. L. Pivovarov, and T. A. Tukhfatullin, Phys. Lett. A 382, 153 (2018).

5 . 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計2件(うち査読付論文 2件 / うち国際共著 2件 / うちオープンアクセス 1件)

1.著者名	4.巻
Y. Takabayashi, Yu. L. Pivovarov, T. A. Tukhfatullin	785
2.論文標題	5 . 発行年
First observation of scattering of sub-GeV electrons in ultrathin Si crystal at planar	2018年
alignment and its relevance to crystal-assisted 1D rainbow scattering	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Physics Letters B	347-353
掲載論文のD01(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.physletb.2018.08.063	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	該当する
1.著者名	4.巻

Y. Takabayashi, Yu. L. Pivovarov, T. A. Tukhfatullin	382
2. 論文標題	5.発行年
Bent crystal channeling of 255 MeV electrons	2018年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Physics Letters A	153-156
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.physleta.2017.11.015	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	該当する

〔学会発表〕 計0件

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

6.研究組織

-

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究分担者	隅谷 和嗣 (SUMITANI Kazushi)	公益財団法人高輝度光科学研究センター・回折・散乱推進 室・研究員	
	(10416381)	(84502)	